

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Шевяков Василий Иванович
2	Дата рождения (полная)	19.04.1952
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук, 05.27.01 - Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты. микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор по кафедре интегральной электроники и микросистем
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 www.miet.ru netadm@miee.ru.
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Автономное учреждение
	Наименование подразделения	Кафедра интегральной электроники и микросистем
	Должность	Главный научный сотрудник, профессор кафедры интегральной электроники и микросистем
7	Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):	
	<p>1. Solnyshkin, A.V., Kislova, I.L., Morsakov, I.M., Shevyakov, V.I., Kiselev, D.A. at al. Dielectric properties of composite materials based on P(VDF-TrFE) copolymer and deuterated triglycine sulfate crystal. Functional Materials Letters. 12(4),1950048. 2019</p> <p>2. Shevyakov, V.I., Solnyshkin, A.V., Kislova, I.L., Belov, A.N., Sandjiev, D.N., Raevskaya, S.I. at al. Photovoltaic and photoelectric response of $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{S}_6$ ferroelectric films. Journal of Advanced Dielectrics. 9(1),1950003. 2019.</p> <p>3. Zotov, A.O., Perevalov, A.A., Shevyakov, V.I., Belov, A.N. Formation features and electrophysical properties of ferroelectric films ZnO study. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 11022,110221D. 2019.</p> <p>4. Golishnikov, A.A., Kostyukov, D.A., Putrya, M.G., Shevyakov, V.I. Features of silicon deep plasma etching process at 3D-TSV structures producing. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 11022,110221Z. 2019.</p> <p>5. Belov, A.N., Golishnikov, A.A., Pestov, G.N., Solnyshkin, A.V., Shevyakov, V.I.</p>	

	<p>Formation of Piezo- and Pyroelectric Matrices with the Use of Nanoprofiled Silica. Nanotechnologies in Russia. 13(11-12), с. 609-613. 2018.</p> <p>6. Solnyshkin, A.V., Kislova, I.L., Belov, A.N., Shevyakov, V.I., Sandjiev, D.N., Raevskaya, S.I. Dielectric dispersion of polycrystalline ferroelectric-semiconductor $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{S}_6$ films. Thin Solid Films. 653, с. 24-28. 2018.</p> <p>7. Baklanova, K.D., Solnyshkin, A.V., Kislova, I.L., Shevyakov, V.I., Kiselev, D.A., Malinkovich, M.D. Pyroelectric Properties and Local Piezoelectric Response of Lithium Niobate Thin Films. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science. 215(5),1700690. 2018.</p> <p>8. Belov, A.N., Golishnikov, A.A., Kislitsin, M.V., Solnyshkin, A.V., Shevyakov, V.I. et. al. Formation of an Array of Memristor Structures Using a Self-Assembly Matrix of Porous Anodic Aluminum Oxide. Nanotechnologies in Russia. 13(1-2), с. 34-37. 2018.</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты